



Comunicato stampa

KIOXIA e Sandisk presentano la tecnologia di memoria flash 3D di nuova generazione che raggiunge una velocità di interfaccia NAND di 4,8 Gb/s

Le aziende presentano in anteprima la tecnologia di memoria flash 3D di 10ª generazione che stabilisce un nuovo punto di riferimento per prestazioni, efficienza energetica e densità di bit

Germania, Düsseldorf, 20 febbraio 2025 – [KIOXIA Corporation](#) e Sandisk Corporation hanno introdotto una tecnologia di memoria flash 3D all'avanguardia, stabilendo il punto di riferimento del settore con una velocità di interfaccia NAND di 4,8 Gb/s, un'efficienza energetica superiore e una maggiore densità.

Presentata all'ISSCC 2025, la nuova innovazione della memoria flash 3D, insieme alla rivoluzionaria tecnologia CBA (CMOS directly Bonded to Array)¹ dell'azienda, incorpora uno dei più recenti standard di interfaccia, Toggle DDR6.0 per la memoria flash NAND e sfrutta il protocollo SCA (Separate Command Address)², un nuovo metodo di input dell'indirizzo di comando della sua interfaccia, e la tecnologia PI-LTT (Power Isolated Low-Tapped Termination)³, fondamentale per ridurre ulteriormente il consumo di energia.

Sfruttando questa esclusiva tecnologia ad alta velocità, le aziende prevedono che la nuova memoria flash 3D consenta di ottenere un miglioramento del 33% della velocità dell'interfaccia NAND rispetto alla memoria flash 3D di ottava generazione attualmente in produzione di massa, raggiungendo una velocità di interfaccia di 4,8 Gb/s. La tecnologia è inoltre in grado di fornire una maggiore efficienza energetica dell'input/output dei dati, riducendo il consumo energetico del 10% per l'input e del 34% per l'output, riuscendo a raggiungere così un equilibrio tra alte prestazioni e



basso consumo energetico. Presentando in anteprima la memoria flash 3D di 10^a generazione, le aziende hanno spiegato che aumentando il numero di strati di memoria a 332 e ottimizzando la planimetria per una maggiore densità planare, la tecnologia migliora la densità di bit del 59%.

"Oltre alla domanda di una maggiore efficienza energetica nei data center, la generazione di dati è destinata ad aumentare notevolmente, trainata da nuove applicazioni basate sulla tecnologia dell'IA, con operazioni sofisticate come l'inferenza all'edge e l'applicazione di tecniche di transfer learning che aggravano ulteriormente i requisiti di archiviazione", afferma Axel Stoermann, Vice President e Chief Technology Officer di KIOXIA Europe GmbH. "KIOXIA continua a gettare le basi a sostegno di questi requisiti di archiviazione del futuro: velocità più elevate, maggiore capacità e minor consumo energetico".

Alper Ilkbahar, SVP of Global Strategy and Technology di Sandisk, ha dichiarato: "Con l'avanzare dell'intelligenza artificiale, le esigenze dei clienti in termini di memoria stanno diventando sempre più diversificate. Attraverso la nostra innovazione tecnologica CBA, miriamo a lanciare prodotti che offrano il miglior abbinamento in termini di capacità, velocità, prestazioni ed efficienza del capitale per soddisfare i nostri clienti in tutti i segmenti di mercato".

KIOXIA e Sandisk hanno anche condiviso i piani per l'imminente memoria flash 3D di 9a generazione. Grazie alla loro esclusiva tecnologia CBA, le aziende possono combinare la nuova tecnologia CMOS con una tecnologia di celle di memoria esistente per fornire prodotti efficienti in termini di capitale, ad alte prestazioni e a basso consumo. Entrambe le aziende rimangono impegnate nello sviluppo di tecnologie di memoria flash all'avanguardia, offrendo soluzioni su misura per soddisfare le esigenze dei clienti e contribuendo al progresso della società digitale.

#

Note:

1: Tecnologia in cui ogni wafer CMOS e wafer di array di celle viene prodotto separatamente nelle proprie condizioni ottimizzate e quindi incollato insieme.

2: Tecnologia in cui il bus per l'input di comando/indirizzo e il bus per il trasferimento dei dati sono completamente separati in bus diversi e vengono utilizzati in parallelo. Ciò riduce il tempo di input/output dei dati.



3: Tecnologia in cui per la fonte di alimentazione dell'interfaccia NAND vengono utilizzate fonti di alimentazione per 1,2 V esistenti e una tensione inferiore aggiuntiva. Ciò riduce il consumo di energia durante l'input/output dei dati.

*1 Gbps viene calcolato come 1.000.000.000 di bit/secondo. Questo valore è ottenuto in un ambiente di test specifico e può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.

* I nomi di aziende, prodotti e servizi possono essere marchi di proprietà di terze parti.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi federali sui titoli, comprese le dichiarazioni relative alle aspettative per la disponibilità, le capacità e l'impatto della tecnologia e dei prodotti Sandisk. Tali dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative della direzione e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali.

I principali rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali includono: sfide e difficoltà operative, finanziarie e legali inerenti all'implementazione dello spin-off dell'attività Flash di Western Digital Corporation a Sandisk; i risultati operativi futuri del business stand-alone Flash; se lo spin-off sarà completato nei termini e nei tempi previsti o del tutto, compresa la possibilità che le condizioni per lo spin-off possano non essere soddisfatte, incluso il fatto che un ente governativo possa vietare, ritardare o rifiutare di concedere l'approvazione necessaria; i benefici e i costi attesi dello spin-off, compreso il fatto che i benefici attesi non saranno realizzati entro il periodo di tempo previsto, in tutto o per niente; potenziali reazioni avverse o modifiche ai rapporti con clienti, fornitori o altri partner derivanti dall'annuncio e dal completamento dello spin-off; risposte competitive all'annuncio o al completamento dello spin-off; costi, passività, oneri o spese imprevisti derivanti dallo spin-off; contenzioso relativo allo spin-off; l'incapacità di trattenere il personale chiave a seguito dello spin-off, l'interruzione dei tempi di gestione delle operazioni aziendali in corso a causa dello spin-off; impatto aziendale dei conflitti geopolitici; e qualsiasi modifica delle condizioni economiche generali e/o specifiche del settore; altri fattori economici, competitivi, legali, governativi, tecnologici e di altro tipo che possono influenzare lo spin-off e altri rischi e incertezze indicati nella dichiarazione informativa finale allegata come Allegato 99.1 alla Dichiarazione di registrazione del modulo 10 di Sandisk Corporation depositata presso la SEC il 27 gennaio 2025, disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. L'utente non deve fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data del presente documento, e Sandisk non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere queste dichiarazioni previsionali per riflettere nuove informazioni o eventi, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.



Informazioni su KIOXIA

KIOXIA è un leader mondiale nelle soluzioni di memoria; si dedica allo sviluppo, alla produzione e alla vendita di memorie flash e di unità a stato solido (SSD). Nell'aprile 2017, il suo predecessore Toshiba Memory è stato scorporato da Toshiba Corporation, la società che ha inventato la memoria flash NAND nel 1987. KIOXIA si impegna a modernizzare il mondo attraverso la "memoria", offrendo prodotti, servizi e sistemi che ampliano il ventaglio di scelte dei clienti e il valore basato sulla memoria per la società. L'innovativa tecnologia di memoria flash 3D di KIOXIA, BiCS FLASH™, sta plasmando il futuro dell'archiviazione in applicazioni ad alta densità, tra cui smartphone avanzati, PC, sistemi automobilistici, data center e sistemi di intelligenza artificiale generativa. Visita il [sito web KIOXIA](#)

Informazioni su Sandisk

Sandisk offre soluzioni Flash innovative e tecnologie di memoria avanzate che soddisfano le persone e le aziende nel punto di intersezione tra le loro aspirazioni e il momento, consentendo loro di continuare a muoversi e dare impulso a ogni possibilità. Sandisk Corporation è una consociata interamente controllata da Western Digital (Nasdaq: WDC). Segui Sandisk su [Instagram](#), [Facebook](#), [X](#), [LinkedIn](#), [Youtube](#). Unisciti a [TeamSandisk](#) su Instagram.

Informazioni di contatto Sandisk

Investitori: Investors@sandisk.com

Media: Mediainquiries@sandisk.com

Contatti per la pubblicazione:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania

Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-mail: KIE-support@kioxia.com

Dettagli dei contatti per richieste editoriali:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-mail: [lena1.hoffmann@kioxia.com](mailto:lana1.hoffmann@kioxia.com)

KIOXIA

Pubblicato da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +49 (0)172 617 8431

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com